IXFK94N50P2

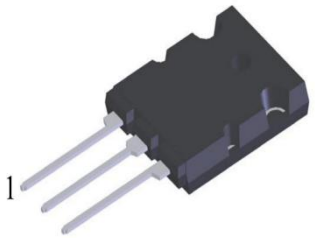
500V N-CHANNEL MOSFET

◆ Features:

- ✧ Fast switching speed
  开关速度快
- ✧ High input impedance and low level drive
  高输入阻抗和低电平驱动
- ✧ Avalanche energy tested
  雪崩能量测试
- ✧ Improved dv/dt capability，high ruggedness
  提高 dv/dt 能力，高耐用性

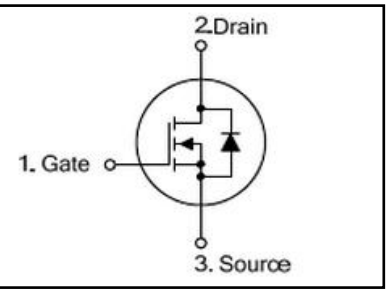
RoHS COMPLIANT

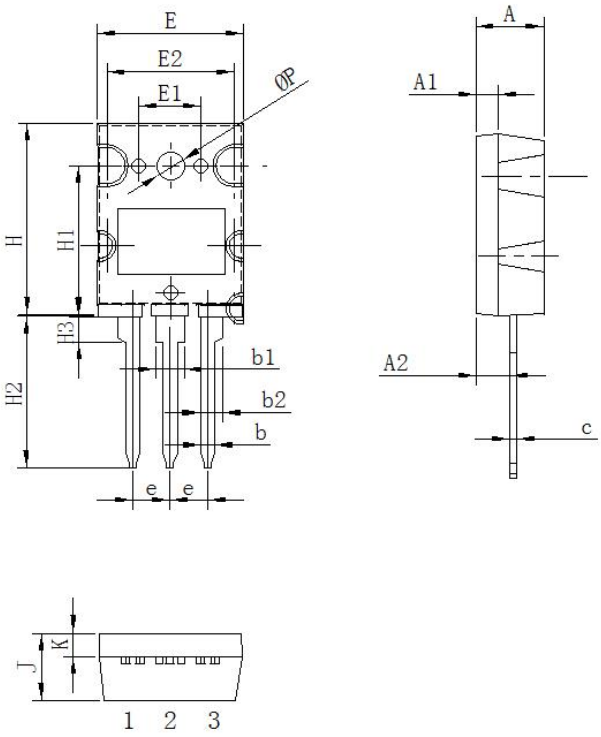
TO-264



◆ Applications

- ✧ High efficiency switch mode power supplies
  高效率开关电源
- ✧ Power factor correction
  功率因数校正
- ✧ Electronic lamp ballast
  电子整流器





Symbol	单位 mm		
	Min	Nom	Max
A	4.80	5.00	5.20
A1	1.80	2.00	2.20
A2	3.20	3.40	3.60
b	0.80	1.00	1.20
b1	2.90	3.10	3.30
b2	2.40	2.60	2.80
c	0.50	0.60	0.70
e	5.25	5.45	5.65
E	19.8	20.0	20.2
E1	17.6	17.8	18.0
E2	8.60	8.80	9.00
H	25.8	26.0	26.2
H1	19.8	20.0	20.2
H2	19.8	20.3	20.8
H3	2.00	2.50	3.00
G	6.00	6.20	6.40
ΦP	3.00	3.20	3.40
J	4.80	5.00	5.20
K	1.30	1.50	1.70

◆ Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

Symbol	Parameters	Ratings	Unit
V_{DSS}	Drain-Source Voltage 漏源电压	**500**	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage-Continuous 栅源电压	**±30**	V
I_D	Drain Current-Continuous（Note 2） 漏极持续电流	**94**	A
I_{DM}	Drain Current-Single Plused（Note 1） 漏极单次脉冲电流	**240**	A
P_D	Power Dissipation （Note 2） 功率损耗	**1300**	W
T_j	Max.Operating junction temperature 最大结温	**150**	℃

◆ Electrical characteristics (Tc=25°C unless otherwise noted)

Symbol	Parameters	Min	Typ	Max	Units	Conditions
Static Characteristics						
B_{VDSS}	Drain-Source Breakdown VoltageCurrent （Note 1） 漏极击穿电压	**500**	--	--	V	I_D=250uA，V_{GS}=0V，T_J=25°C
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage 栅极开启电压	**3**	--	**5**	V	V_{DS}=V_{GS}，I_D=250uA
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-Resistance 漏源导通电阻	--	--	**60**	mΩ	V_{GS}=10V，I_D=47A
I_{GSS}	Gate-Body Leakage Current 栅极漏电流	--	--	**±100**	nA	V_{GS}=±30V，V_{DS}=0
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current 零栅极电压漏极电流	--	--	**10**	μA	V_{DS}=500V，V_{GS}=0
gfs	Forward Transconductance 正向跨导	--	**75**	--	S	V_{DS}=10V，I_D=47A

Switching Characteristics						
$T_{d(on)}$	Turn-On Delay Time 开启延迟时间	--	**35**	--	ns	V_{DS}=250V， I_D=47A， R_G=1Ω（Note 2）
T_r	Rise Time 上升时间	--	**15**	--	ns	
$T_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time 关闭延迟时间	--	**75**	--	ns	
T_f	Fall Time 下降时间	--	**15**	--	ns	
Q_g	Total Gate Charge 栅极总电荷	--	**230**	--	nC	V_{DS}=250V， V_{GS}=10V， I_D=47A（Note 2）
Q_{gs}	Gate-Source Charge 栅源极电荷	--	**65**	--	nC	
Q_{gd}	Gate-Drain Charge 栅漏极电荷	--	**80**	--	nC	
Dynamic Characteristics						
C_{iss}	Input Capacitance 输入电容	--	**14**	--	pF	V_{DS}=25V，V_{GS}=0， f=1MHz
C_{oss}	Output Capacitance 输出电容	--	**1390**	--	pF	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance 反向传输电容	--	**33**	--	pF	
I_S	Continuous Drain-Source Diode Forward Current（Note 2） 二极管导通正向持续电流	--	--	**94**	A	
V_{SD}	Diode Forward On-Voltage 二极管正向导通电压	--	--	**1.4**	V	I_S=94A，V_{GS}=0
$R_{th(j-c)}$	Thermal Resistance, Junction to Case 结到外壳的热阻	--	--	**0.10**	°C/W	

Note 1: Repetitive Rating : Pulse width limited by maximum junction temperature

Note 2: Pulse test: PW <= 300us , duty cycle <= 2%.